



**Effect of substitution of cobalt on crystal structure and  
magnetoresistance of  $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.2}\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_3$  compositions,  
prepared by sol-gel technique**

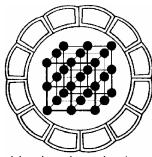
**M. R. Alinejad, N. Tajabor, S. Masoomi**

*Dept. of Physics, Faculty of Sciences, Ferdowsi Univ. of Mashhad, Iran.  
E-mail: alinejad@ferdowsi.um.ac.ir*

(Received: 10/3/2006, received in revised form: 2/9/2006)

**Abstract:** The  $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.2}\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_3$  ( $0 \leq X \leq 1$ ) Manganite-Cobaltites are synthesized by sol-gel method and their structural, electrical and magnetic properties are studied. After calcination over  $800^\circ\text{C}$ , all compounds were crystallized in the perovskite rhombohedral structure ( $\text{R}\bar{3}\text{C}$ , Space group). Due to nonstoichiometry, some traces of the  $\text{La}_2\text{O}_3$  phase were appeared in final samples. Resistivity measurements of the samples between 77 and 328 K revealed that resistivity at first decreased and then increased by increasing cobalt content. Also, magnetoresistance results in presence of external fields up to 1.5 T exhibit negative magnetoresistance in all samples. The colossal magnetoresistance effect has been observed in all samples except the samples without Mn. Variation of the resistivity and magnetoresistance of the samples with Co content are described based on three following mechanisms: spin scattering, charge compensation and distortion of metal-oxygen-metal bonds. Magnetoresistance behavior of the samples are evaluated based on (1) increased of the double exchange interaction, (2) increased probability of inter-grain tunneling of the carriers, and (3) decreased scattering of carriers from magnetic fluctuations mechanism in the presence of applied field,

**Keywords:** *Manganite- Cobaltite, Sol - gel,  $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.2}\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_3$ , Double exchange, Cossal magnetoresistance (CMR).*



## مطالعه اثر جانشانی کبالت بر ساختار بلوری و مغناطومقاومت ترکیبات $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.2}\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_3$ -زل

محمد رضا علی‌نژاد، ناصر تجبر، ساره معصومی

مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

پست الکترونیکی: [alinejad@ferdowsi.um.ac.ir](mailto:alinejad@ferdowsi.um.ac.ir)

(دریافت مقاله ۱۳۸۴/۱۲/۱۹، دریافت نسخه نهایی ۸۵/۶/۱۱)

**چکیده:** در این پژوهش خواص ساختاری، الکتریکی، و مغناطیسی منگانایت-کبالاتایت‌های  $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.2}\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_3$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) تهیه شده به روش سل-زل، بررسی شدند. ساختار بلوری این ترکیبها در دمای اتاق به صورت فاپرووسکایت لوزی‌رخ با گروه فضایی  $\bar{R}\bar{3}C$  بوده است که پس از تکلیس در دماهای بالاتر از  $800^\circ\text{C}$  شکل می‌گیرد. به علت عدم موازنۀ عنصری، رگه‌هایی از فاز  $\text{La}_2\text{O}_3$  نیز در نمونه‌های نهایی دیده می‌شوند. اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی نمونه‌ها در بازۀ دمایی ۷۷ تا ۳۲۸ K نشان داد که با افزایش جانشانی کبالت به جای منگنز، مقاومت ویژه الکتریکی نخست افزایش و سپس کاهش می‌یابد. همچنین اعمال یک میدان مغناطیسی به بزرگی  $T_{1/5}$  نشان داد که مغناطومقاومت در تمام نمونه‌ها منفی است. اثر مغناطومقاومت ابرغول آسا (CMR)، به جز در نمونه فاقد عنصر منگنز، در سایر نمونه‌ها مشاهده می‌شود. تغییرات مقاومت نمونه‌ها با میزان جانشانی عنصر کبالت براساس سه سازوکار پراکندگی اسپینی، جبران بار الکتریکی، و واپیچش پیوند فلز-الکترون-فلز توصیف می‌شود. از طرف دیگر، رفتار مغناطومقاومت نمونه‌ها بر اساس تقویت برهم‌کنش مبادله دوتایی در حضور میدان مغناطیسی، افزایش احتمال تونل‌زنی حاملها بین خوشه‌ها، و کاهش احتمال پراکندگی حاملها از بین‌نظمی‌های مغناطیسی مورد بحث قرار گرفت.

**واژه‌های کلیدی:** منگانایت-کبالاتایت، سل-زل- $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.2}\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_3$ ، مبادله دوتایی، مغناطومقاومت ابرغول آسا (CMR).

## مقدمه

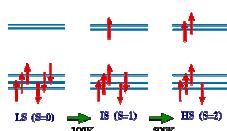
منگانایتها خانواده‌ای از اکسیدهای منگنز با فرمول شیمیایی  $A_{1-y}B_yMnO_2$  هستند که در آنها A یک عنصر خاکی نادر سه ظرفیتی مثل  $La^{+3}$ ، و B یک فلز قلیایی دو ظرفیتی مثل  $Sr^{+2}$  است. طی دهه گذشته، ویژگیهای غیرمعمول و نمودار فاز پیچیده این ترکیبها توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است که در مرجع [۱] مرور کاملی از آنها آورده شده است. در منگانایتها، همبستگیهای گسترده‌ای بین درجات آزادی متنوعی مثل اسپین، بار، اربیتال، و شبکه بلوری وجود دارند که می‌توانند خاستگاه نظامهای مختلفی مثل نظم اسپینی، نظم بار، و نظم شبکه‌ای باشند. همچنین برهم‌کنش‌های مهمی مثل برهم‌کنش الکترون-فونون، تبادلی، هوند، و جان‌تلر، غالباً و به شدت با هم در رقابت‌اند. این عوامل، خاستگاه سرشتیهای بسیاری در منگانایتها را تشکیل می‌دهند که مغناطومقاومت از مهم‌ترین آنهاست. این سرشتی اساس کار نوکهای مغناطیسی، حافظه‌های مغناطیسی، ضبط مغناطیسی، احساسگرهای میدان مغناطیسی، و کلیدزنی مغناطیسی است. از دیگر کاربردهای مهم منگانایتها، استفاده از آنها به عنوان کاتد در پیلهای سوختی اکسید جامد است که ترکیب  $La_{1-y}Sr_yMn_{1-x}Co_xO_2$  از جمله کاتدهای خوب شناخته شده است [۲].

ترکیبها  $La_{1-y}Sr_yMn_2$  و  $La_{1-y}Sr_yCo_2$  از این نظر که با ایجاد حفره در آنها (یعنی با تبدیل  $Co^{+4}$  و  $Mn^{+4}$  به  $Co^{+3}$  و  $Mn^{+3}$ ) فرومغناطیس می‌شوند، با هم مشابه‌اند. اما خاستگاه مغناطومقاومت در این دو ترکیب کاملاً متفاوت است که به پیکربندی‌های اسپینی مختلف یونهای کبالت مربوط می‌شود [۳]. در واقع مغناطومقاومت منفی منگانایتها ریشه در برهم‌کنش تبادلی دوتایی در زنجیره  $Mn^{+4}-O-Mn^{+3}$  دارد که یونهای  $Mn^{+4}$  به واسطه نشستن  $Sr$  به جای La شکل می‌گیرند و هر دو یون در حالت اسپینی بالای خود قرار دارند. در مقابل، مغناطومقاومت منفی کبالتایتها ناشی از رشد خوش‌های فرومغناطیسی در حضور میدان خارجی و در نتیجه افزایش احتمالی نفوذ حاملها بین آنهاست. هر خوشة فرومغناطیسی متشکل از یک یا چند یون  $Co^{+4}$  در حالت اسپینی پایین (LS) است که با کاتیونهای  $Co^{+3}$  در حالت اسپینی متوسط (IS) پوشیده شده‌اند.<sup>۱</sup>

۱- کبالت بسته به دما یکی از سه حالت اسپینی مختلف زیر را اختیار می‌کند (IS: Low-spin State، LS: High-spin State، Intermediate-spin State).

اگر توجه شود که مغناطیومقاومت اشباعی منگانایت تنها در میدانهای نسبتاً شدید ( $H > 1\text{ T}$ ) و کبالتایت در میدانهای ضعیفتر ( $H < 1\text{ T}$ ) [۱] شکل می‌گیرد، می‌توان انتظار داشت که با نشاندن Co به جای Mn و حضور هم‌مان هر دو عامل بالا، امکان مشاهده مغناطیومقاومت بزرگ در میدانهای نسبتاً ضعیفتر فراهم شود. این انتظار ما را بر آن داشت تا خواص مغناطیوتراپری ترکیب‌های کبالتایت-منگانایت را به طور اصولی بررسی کنیم. پیش از این، خواص ساختاری [۴ تا ۷]، مغناطیسی [۸ تا ۱۲] و تراپری [۱۰ تا ۱۷] این ترکیبها در بازه-های ترکیبی محدودی مطالعه و گزارش شده است. اما، مغناطیومقاومت نمونه‌های  $\text{Mn}_{1-x}\text{O}$  در تمام بازه ترکیبی ( $1 \leq x \leq 0$ ) در مراجع مشاهده نشد. اندازه‌گیری مغناطیومقاومت نمونه‌های غیر موازن‌های اینچنین (یعنی در حالی که در نمونه موازن، مجموع شاخصهای La و Sr برابر با یک باشد ولی در اینجا داریم:  $1 < 0.95 + 0.2 = 0.75$ ) که دارای ریزساختار ویژه‌ای هستند [۱۸]، که می‌تواند در بردارنده اطلاعات بی‌نظیری باشد که از نظر علمی و کاربردی بسیار با اهمیتند، به ویژه وقتی که نمونه‌ها به روش سل-زل تهیه شده باشند.

در واقع، منگانایت - کبالتایت‌های کپه‌ای معمولاً به یکی از دو روش واکنش در فاز جامد یا سل-زل ساخته می‌شوند. با توجه به برتریهای روش سل-زل نسبت به روش‌های دیگر، از جمله تولید پودر اولیه بسیار ریز، همگن، مراحل ساخت کمتر، و به ویژه بی‌نیازی از آسیاب‌کاری‌های طولانی، معمولاً روش سل-زل ترجیح داده می‌شود [۱ و ۱۹]. در روش سل-زل، نخست پودر عناصر اولیه در یک حل محل مناسب حل می‌شوند. سپس یک عامل کمپلکس‌ساز با کاتیون‌ها پیوند هیدروژنی ضعیف تشکیل می‌دهد. گاهی یک عامل پلیمرساز نیز به این مجموعه افزوده می‌شود که با قطبی کردن کمپلکس‌ها، آنها را به شکل زنجیره‌های پلیمری به هم وصل کرده و حالت کلوییدی ژل مانندی را به وجود می‌آورد. با گرمادهی محلول، پایه‌های هیدروکربنی تشکیل دهنده زنجیره‌های پلیمری به صورت گاز خارج شده و یونها با شعاع‌های مناسب در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. این توزیع همگن از یونهای فلزی، زمینهٔ تشکیل سریعتر ترکیب مورد نظر در دمایی نسبتاً پایینتر را فراهم می‌آورد.



### روش کار

برای ساخت  $10\text{ gr}$  ترکیب  $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.2}\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_2$  با  $x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$  مواد اولیه لازم مطابق جدول ۱ انتخاب شدند. در ساخت نمونه‌ها به روش سل - ژل، نخست آب مقطر در حمام آب‌گرم با دمای  $40^\circ\text{C}$  یون زدایی شد. سپس با یک همزن  $150\text{ cc}$  مغناطیسی که محلول همزده می‌شد، به ترتیب مقادیر مناسب اسید سیتریک (معادل با دو برابر مولی یونهای فلزی)، اکسید لانتانیم، نیترات استرانسیم، نیترات منگنز، و نیترات کبالت به آن اضافه شدند. برای حل اکسید لانتانیم، از اسید نیتریک رقیق استفاده شد. سپس مقداری مناسب اتیلن گلیکول به عنوان عامل پلیمرساز، قطره قطره به این محلول اضافه شد. پس از شفاف شدن محلول، دمای آن به  $70^\circ\text{C}$  افزایش داده شد تا نمونه تقریباً خشک شود. آنگاه عملیات خشکسازی کامل به مدت  $4$  ساعت در کوره‌ای در دمای  $400^\circ\text{C}$  انجام گرفت. پودر به دست آمده به مدت  $2$  ساعت در دمای  $600^\circ\text{C}$  تصفیه و به دنبال آن به مدت  $6$  ساعت در دمای  $800^\circ\text{C}$  کلسینه شد. پس از فشرده‌سازی زیر فشار  $200\text{ MPa}$  و تولید قرص‌هایی به قطر  $8\text{ mm}$ ، نمونه‌های به دست آمده به مدت  $6$  ساعت در دمای  $1100^\circ\text{C}$  تفحوشی شدند. مراحل ساخت نمونه‌ها در شکل ۱ ارائه شده است. شرایط ساخت بر اساس اطلاعات ارائه شده در مراجع انتخاب و به روش سعی و خطأ تنظیم شدند [۲۱ تا ۲۳].

ساختار بلوری و ترکیب فازی نمونه‌ها به روش پراش پرتو  $X$  با تابش  $\text{Mo-K}_\alpha$  ( $\lambda = 0.07093\text{\AA}$ ) بررسی شدند. تحلیل الگوهای پراشی برای تعیین پارامترهای شبکه بلوری، با نرم افزار Celref انجام گرفت. ورودی این نرم‌افزار، مکان قله‌های پراشی برآک است که پس از انتخاب گروه فضایی مناسب، پارامترهای شبکه بلوری با دقیقیت بهتر از  $0.1^\circ$  توسط نرم‌افزار قابل محاسبه است.

مقاومت ویژه الکتریکی و مغناطیسی مقاومت نمونه‌ها به روش چارسوزنی اندازه‌گیری شدند. اتصالات الکتریکی مورد نیاز برای این اندازه‌گیریها با چسب نقره صورت گرفت.

**جدول ۱** مقدار مواد اولیه انتخاب شده برای ساخت  $10\text{ gr}$  از ترکیبات  $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.2}\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_2$  با  $x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$

X	$C_6H_8O_7 \cdot H_2O$ (gr)	$C_7H_4(OH)_2$ (milt)	$H_2O$ (milt)	$La_2O_3$ (gr)	$Sr(NO_3)_2$ (gr)	$Mn(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ (gr)	$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ (gr)
X=•₁•	۲۹/۱۸	۱۹/۴۲	۱۵۰	۴/۳۵	۱/۵۱	۸/۹۴	•/•
X=•₂	//	//	//	//	//	۷/۱۵	۲/۰۷
X=•₄	//	//	//	//	//	۵/۳۶	۴/۱۴
X=•₆	//	//	//	//	//	۳/۵۷	۶/۲۲
X=•₈	//	//	//	//	//	۱/۷۹	۸/۲۹
X=۱/•	//	//	//	//	//	•/•	۱۰/۳۶

انتخاب مواد اولیه مطابق با جدول ۱ و حل کردن آنها در ۵۰۰ cc آب یونزدایی شده در دمای ۴۰°C همراه با همزن مغناطیسی

افزودن ۱۹/۴۲ cc  $C_7H_4(OH)_2$  و ادامه گرمادهی تا محلول شفاف شود

ادامه گرمادهی در ۷۰°C بدون همزن در حمام آب گرم تا ژل تشکیل شود

گرمادهی در ۴۰°C بدون همزن در گوره به مدت ۴ ساعت تا ژل کاملاً خشک شود

پودرسازی در هاون دستی و سپس فشردهسازی با فشار کم

تصفیه کردن در دمای ۶۰۰°C به مدت ۲ ساعت و سپس تکلیس در دمای ۸۰۰°C به مدت ۶ ساعت (افراش دما تدریجی)

پودرسازی در هاون دستی به مدت ۱ ساعت و سپس فشردهسازی تحت فشار ۲۰۰ MPa

تفجیوشی در دمای ۱۱۰۰°C به مدت ۶ ساعت

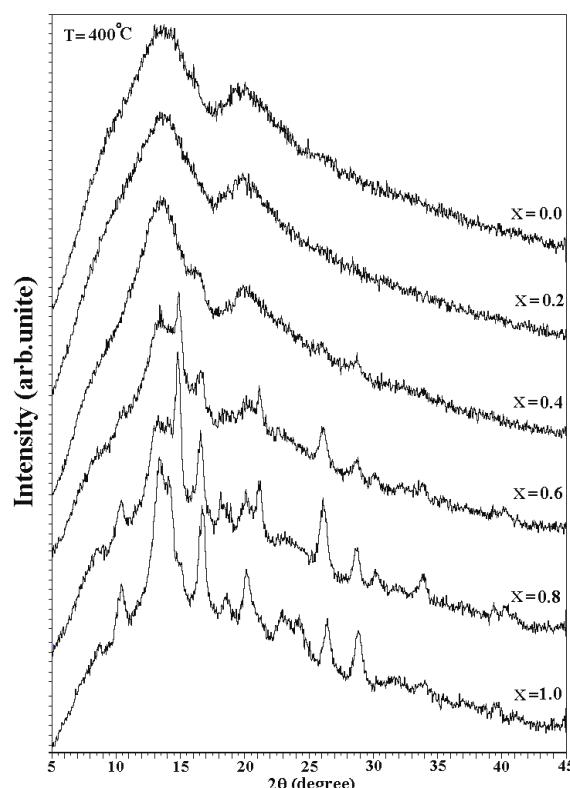
شکل ۱ نمودار مراحل ساخت نمونه‌ها.

#### نتایج بررسیهای ساختاری

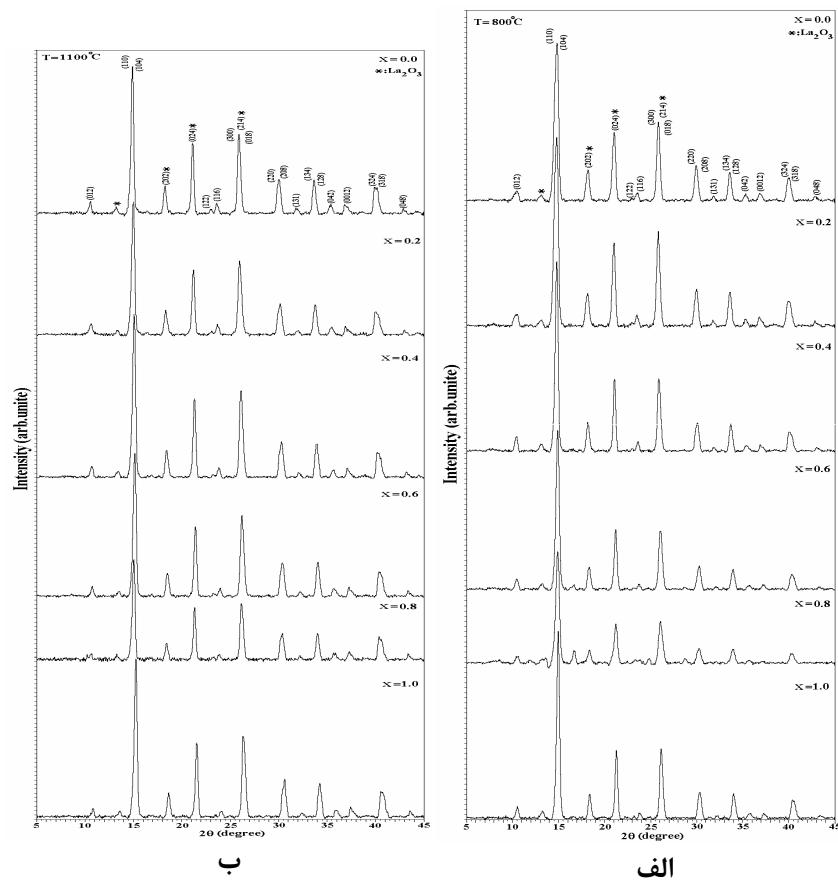
الگوی پراش پرتو X ترکیب  $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.2}\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_3$  با  $x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$  در دمای  $400^\circ\text{C}$ ، تکلیس در دمای  $1100^\circ\text{C}$ ، پس از خشکسازی در دمای  $400^\circ\text{C}$  و تفحوشی در دمای  $1100^\circ\text{C}$  در شکل های ۲ و ۳ ارائه شده‌اند. شکل ۲ نشان دهنده وجود یک زمینه آمورف در پودرهای خشک شده در دمای  $400^\circ\text{C}$  است. در سه نمونه اول که مقدار Mn بیشتر است، این فاز آمورف با فاز بلوری خاصی همراهی نمی‌شود در حالی که در سه نمونه آخر، فاز لوزی رخ به میزان جزیی شکل گرفته است. این پدیده نشان می‌دهد که وجود کبالت، دمای تشکیل فاز پرووسکایت مورد نظر را کاهش داده است. نتایج به دست آمده از گرماسنجی دیفرانسیلی (DTA-TGA) در مرجع [۸] نیز این اثر جانشانی کبالت را تأیید می‌کنند. این نتیجه می‌تواند ناشی از الکترونگاتیویتۀ بیشتر کبالت (۱/۸۸) نسبت به منگنز (۰/۵۵) و نیز پایین‌تر بودن انرژی آنتالپی تشکیل پیوند O-O ( $348.5 \text{ kJ/mol}$ ) در مقایسه با Mn-O ( $402.9 \text{ kJ/mol}$ ) باشد.

با توجه به شکل ۳-الف می‌توان گفت که پس از تکلیس در دمای  $400^\circ\text{C}$ ، ساختار بلوری پرووسکایت لوزی رخ با گروه فضایی  $R\bar{3}C$  در همه نمونه‌ها شکل گرفته است. با توجه به این که دمای تشکیل فاز پرووسکایت در منگانایت‌های ساخته شده به روش‌های دیگر (مثل واکنش حالت جامد) بالاتر از  $1000^\circ\text{C}$  [۱ و ۴]، کاهش حدود ۲۰ درصد دمای تشکیل فاز پرووسکایت در پودرهای آماده شده به روش سل-ژل از نظر کاربردی بسیار با ارزش است. این نتیجه می‌تواند ناشی از سرعت بیشتر نفوذ یونهای فلزی که به طور همگن توزیع شده‌اند، در ذرات بسیار ریز موجود در محصول سل-ژل باشد.

پارامترهای شبکه بلوری فاز پرووسکایت که بر اساس الگوهای پراش حاصل از نمونه‌های تفحوشی شده در شکل ۳-ب محاسبه شده‌اند، در جدول ۲ ارائه شده است. همچنین، تغییر این پارامترها با میزان ناخالصی کبالت نیز در شکل ۴ رسم شده است. با توجه به شاعع کوچکتر یونهای کبالت نسبت به منگنز (جدول ۳) انتظار می‌رود که با نشاندن کبالت به جای منگنز، ثابت‌های شبکه بلوری کاهش یابند که این امر با نتایج به دست آمده در این کار پژوهشی سازگار است.



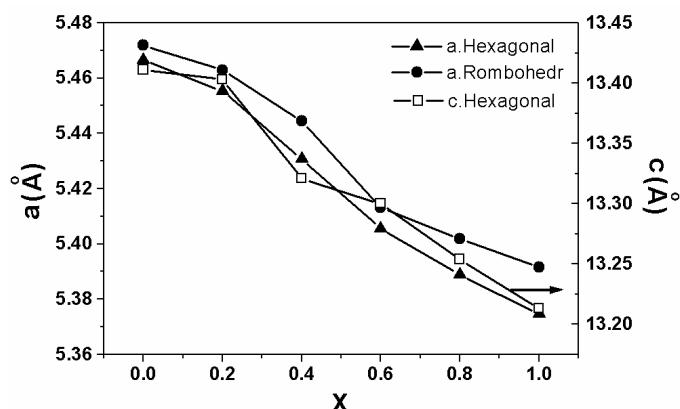
شکل ۲ الگوهای پراش پرتو X (λ = 0.7093 Å) ترکیب La<sub>0.75</sub>Sr<sub>0.25</sub>Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>O<sub>7</sub> به ازای مقادیر مختلف X، پس از خشکاندن در دمای ۴۰۰ °C.



شکل ۳ (الف) الگوی پراش پرتو X پس از تکلیس در دمای  $800^{\circ}\text{C}$ . (ب) طرح پراش پرتو X پس از تفجوشی در دمای  $1100^{\circ}\text{C}$ .

جدول ۲ پارامترهای شبکه لوزی رخ با گروه فضایی  $\bar{R}\bar{3}C$  براساس بردارهای پایه ششگوشی و لوزی رخ.

نام ترکیب	براساس محورهای ششگوشی			براساس محور لوزی رخ لوزی رخ	
	$a (\text{\AA})$	$c (\text{\AA})$	$v (\text{\AA})^3$	$a (\text{\AA})$	$v (\text{\AA})^3$
$\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.17}\text{MnO}_3$	5.4665	13.4110	347.062	5.4719	115.64
$\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.17}\text{Mn}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{O}_3$	5.4553	13.4029	345.430	5.4629	114.892
$\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.17}\text{Mn}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{O}_3$	5.4307	13.3209	340.228	5.4444	113.824
$\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.17}\text{Mn}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{O}_3$	5.4055	13.3000	336.550	5.4131	112.112
$\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.17}\text{Mn}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{O}_3$	5.3888	13.2537	332.308	5.4018	111.213
$\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.17}\text{CoO}_3$	5.3748	13.2131	330.566	5.3916	111.110



شکل ۴ تغییرات پارامترهای شبکه بلوری با میزان ناخالصی کبالت، محاسبه شده بر اساس بردارهای پایه ششگوشی و لوزی رخ.

جدول ۳ شعاع یونی Mn و Co.[۱۴]

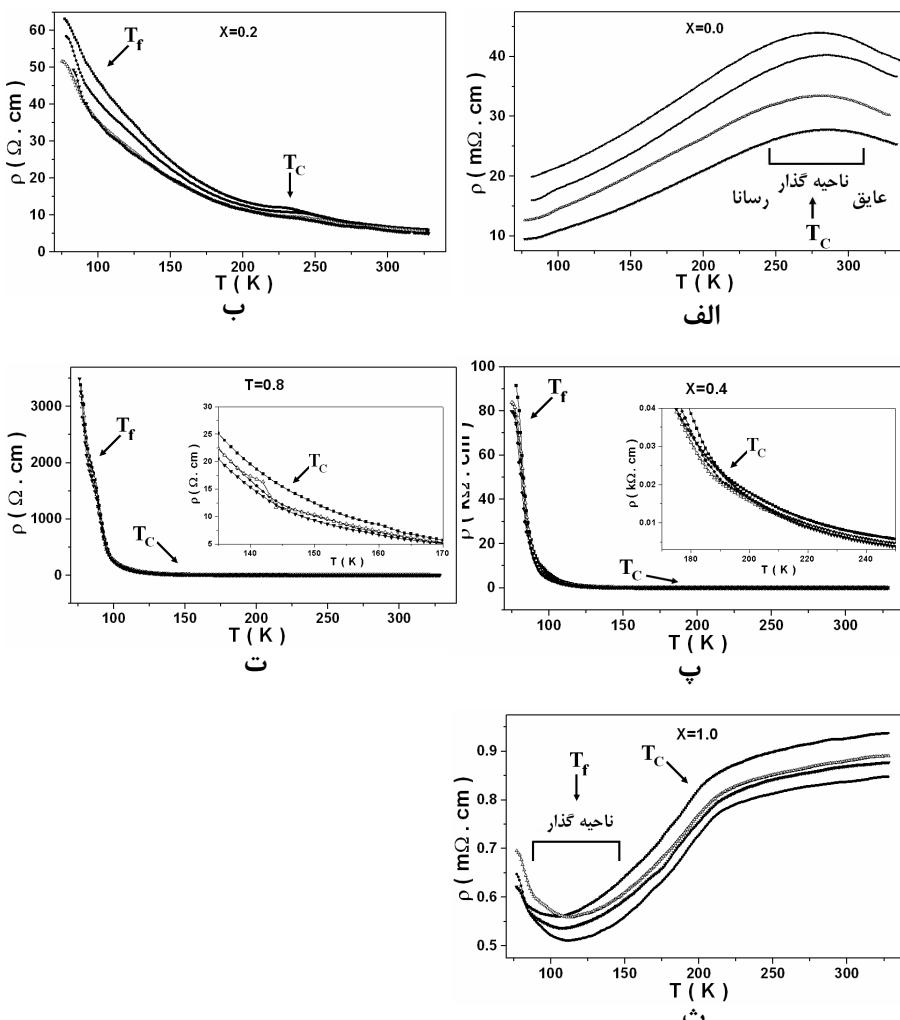
نام یون	شعاع یونی (Å)
(IS) $\text{Co}^{+3}$	۰,۵۴۵
(HS) $\text{Co}^{+3}$	۰,۶۱۸
(HS) $\text{Co}^{+4}$	۰,۵۳
$\text{Mn}^{+3}$	۰,۶۴۵
$\text{Mn}^{+4}$	۰,۵۳

### های الکتریکی

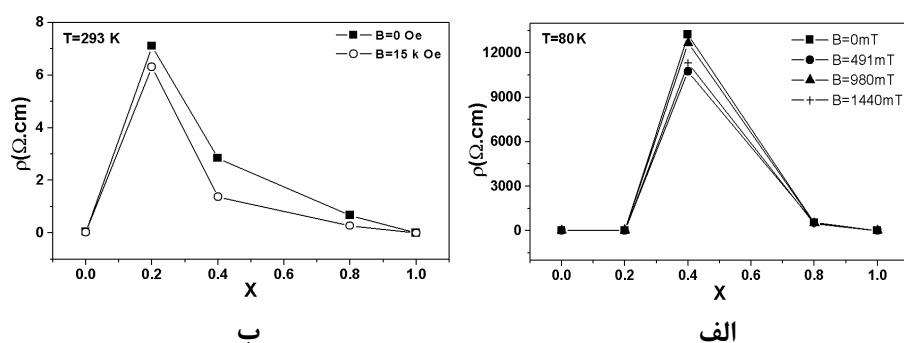
### نتایج اندازه‌گیری-

وابستگی دمایی مقاومت ویژه الکتریکی نمونه‌ها در شکل ۵ نشان داده شده است. مقایسه منحنی‌های مقاومت ویژه الکتریکی نمونه‌های مختلف نشان می‌دهد که با نشاندن کمالت به جای منگنز، مقاومت الکتریکی نخست افزایش و سپس کاهش می‌یابد. این نتیجه در شکل ۶ که تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی با میزان ناخالصی کمالت در دمای اتاق ۸۰K را نشان می‌دهد نیز دیده می‌شود. این پدیده را می‌توان بر اساس سه سازوکار زیر توضیح داد:

۱- با نشاندن Co به جای Mn در پیوندهای Mn-O-Mn، زاویه پیوند از حالت خطی (۱۸۰ درجه) واپیچیده می‌شود. گرچه این واپیچش‌ها آنقدر بزرگ نیستند که ساختار لوزی‌رخ را تغییر دهند، اما موجب افزایش پراکندگی حاملهای جریان و در نتیجه افزایش مقاومت ویژه الکتریکی می‌شوند. با افزایش میزان جانشانی به نحوی که چگالی تعداد یونهای کمالت بیشتر از منگنز شود، تعداد پیوندهایی که دارای شکل خطی Co-O-Co هستند به تدریج افزایش و در نتیجه مقاومت ویژه الکتریکی کاهش می‌یابد.



شکل ۵ بستگی دمایی مقاومت ویژه الکتریکی نمونه‌های  $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.25}\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_2$  و مقادیر  $x$  مشخص شده روی هر شکل که در حضور میدانهای مغناطیسی خارجی ثابت اندازه‌گیری شده‌اند (H = ۱۵ kOe : ▼, H = ۱۰ kOe : Δ, H = ۵ kOe : ●, H = ۰ Oe : ■) (TC = دمای گذار فرومغناطیسی به پارامغناطیس و Tf = دمای گذار حالت اسپین کم به حالت اسپین متوسط کبالت را نشان می‌دهد).



شکل ۶ وا استگی مقاومت ویژه الکتریکی به مقدار کبالت در دو دمای ۲۹۳ K و ۸۰ K

۲- آرایش پادموازی گشتاور مغناطیسی یونهای کبالت و منگنز نسبت به هم نشان می‌دهد که سازوکار برهم‌کنش مبادله دوتایی<sup>۲</sup> برای پیوندهای ناهم‌جنس Mn-O-Co فعال نیست [۸]. لذا افزایش پیوندهای نامتجانس با افزایش مقاومت ویژه الکتریکی همراه است.

۳- با نشاندن Co به جای Mn، حاملهای جریان به تدریج از حفره به الکترون تغییر می‌یابند به نحوی که فرایند بازترکیب و جبران حاملها<sup>۳</sup> رخ می‌دهد [۷ و ۱۵]، در نتیجه تعداد حاملها کاهش یافته و مقاومت ویژه الکتریکی افزایش می‌یابد. با افزایش بیشتر میزان ناخالصی کبالت، تعداد الکترونها نسبت به حفره‌ها بیشتر می‌شود که افزایش تعداد حاملها و کاهش مقاومت ویژه الکتریکی را در پی دارد.

چنانکه در شکل ۵ دیده می‌شود، مقاومت ویژه همه نمونه‌ها در دمای گذار فرو به پارامغناطیس (T<sub>C</sub>) با تغییراتی همراه است که این تغییرات در منحنی‌های مربوط به نمونه‌هایی با مقاومت ویژه کوچکتر بهتر دیده می‌شوند. افزون بر این، در حالی که مقاومت ویژه نمونه‌های ۰,۸، ۰,۴ و ۰,۲ = x در سرتاسر بازه دمایی ۷۷ تا ۳۰۰ K رفتاری نیمرسانانگونه دارد، اما شکل ۵-الف نشان دهنده یک گذار فاز رسانا به نیمرسانا با افزایش دما در نمونه La<sub>۰,۷۵</sub>Sr<sub>۰,۲۵</sub>MnO<sub>۳</sub> در حدود K = ۲۷۸ T<sub>C</sub> است که با نتایج پیشین سازگار است [۹ و ۱۲]. در واقع رفتار فلزی، ریشه در نظم فرومغناطیسی حاصل از برهم‌کنش مبادله دوتایی دارد که در نمونه‌های ۰,۸، ۰,۴ و ۰,۲ = x با پیوندهای نامتجانس Mn-O-Co، بسیار ضعیف است. در نمونه منگانایت فاقد کبالت (۰ = x) نیز با افزایش دما و در نتیجه افزایش حرک حاملها، این نظم به تدریج ضعیف می‌شود و در دماهای بالاتر از دمای گذار T<sub>C</sub> عملًا از بین می‌رود. همزمان با حذف برهم‌کنش مبادله دوتایی، رفتار نیمرسانانگونه سرشتی منگانایتها ظاهر می‌شود. با وجود این، رفتار مقاومت ویژه نمونه کبالتایت (۱ = x) در دو سوی دمای T<sub>C</sub> رسانانگونه است زیرا سازوکار برهم‌کنش تبادلی در این ترکیب از نوع بلنبدبرد RKKY است که به واسطه قطبش الکترونها نوار رسانش شکل می‌گیرد [۱۰ و ۱۵].

از سوی دیگر، دو دمای گذار T<sub>C</sub> و T<sub>f</sub> در منحنی مقاومت ویژه نمونه‌های ۰,۸، ۰,۴ و ۰,۲ = x در شکل‌های ۵-ب تا ۵-ت دیده می‌شوند. این دو به ترتیب با دمای گذار فرو به پارامغناطیس، و دمای گذار بین حالت‌های اسپینی مختلف کبالت قابل مقایسه هستند [۱۰ و ۱۱]. نتایج قبلی پیرامون ترکیبات ناموازن‌های همچون نمونه‌های حاضر نشان داده‌اند که

<sup>2</sup>- Double exchange

<sup>3</sup>- Charge compensation and charge recombination.

در دماهای پایین تر از  $T_C$ ، خوشه‌های فرومغناطیس (مربوط به برهم‌کنش مبادله دوتایی یونهای همنام) در زمینه‌ای از فاز پادفرومغناطیس (مربوط به برهم‌کنش آبرتابالی یونهای ناهمنام) حضور دارند که در دماهای بالاتر از  $T_C$  بر اثر ارتعاشهای گرمایی بی‌نظم می‌شوند و فاز پارامغناطیس شکل می‌گیرد [۱۸ و ۲۲]. گرچه خوشه‌های فرومغناطیس رسانا هستند اما فراوانی آنها تابعی از مقدار کبالت موجود در نمونه است. در این شرایط، مقاومت ویژه نمونه‌ها بیشتر تابعی از رفتار الکتریکی فاز زمینه و نیز احتمال تولیزی حاملهای جریان بین خوشه-هاست، که اولی رفتار نیمرساناگونه و دومی رساناگونه را گسترش می‌دهد. لذا با توجه به شکل  $5$  می‌توان گفت، در حالی که رفتار خوشه‌ها در مقاومت ویژه نمونه‌های  $1$  و  $۰$  در  $T_C < x = ۰$  غالب است، اما رفتار مقاومت ویژه نمونه‌های دیگر در این ناحیه دمایی بیشتر متأثر از فاز پادفرومغناطیس زمینه است.

در مواد نیمرسانا، افزایش دما موجب افزایش تعداد الکترون‌های نوار رسانش و در نتیجه کاهش نمایی مقاومت الکتریکی می‌شود که این ویژگی مبنای روش گرمایی برای اندازه‌گیری گاف انرژی است. از برآش مقاومت ویژه نمونه‌های  $۰/۸$ ،  $۰/۴$  و  $۰/۲$  با رابطه  $(E_g / k_B T) = \rho_0 \exp(E_g / k_B T)$  در این نمونه‌ها محاسبه شد که نتایج حاصل در جدول  $4$  ارائه شده‌اند.

پیش از این گفته شد که در دمای  $T_f$ ، گذار بین حالت‌های اسپینی مختلف کبالت صورت می‌گیرد. در واقع کبالتایتها حالت یخزدگی بی‌نظم اسپینی<sup>۴</sup> (SG) و یخزدگی بی‌نظم خوشه‌ای<sup>۵</sup> (CG) را در دماهای پایین به نمایش می‌گذارند که موجب افزایش چشمگیر مقاومت ویژه آنها در دماهای پایین می‌شود [۱۰]. افزایش دما موجب حذف حالت SG و CG خواهد شد، لذا رفتار عادی مقاومت ویژه ظاهر می‌شود. این تغییر رفتار در مقاومت ویژه الکتریکی نمونه رفتار عادی مقاومت ویژه می‌شود. این پیوندهای Co-O-Co، رفتار عادی مقاومت ویژه می‌شود که با توجه به متجانس و خطی بودن پیوندهای  $\text{La}_{۰/۷۵}\text{Sr}_{۰/۲}\text{CoO}_۳$  این نمونه رساناگونه است که البته ضریب دمایی آن در دو سمت  $T_C$  متفاوت است.

وابستگی دمایی مغناطیس مقاومت نمونه‌ها در شکل  $7$  نشان داده شده است، که دماهای  $T_C$  و  $T_f$  نیز روی این شکلها مشخص شده‌اند. مشاهده می‌شود که مغناطیس مقاومت همه نمونه‌ها منفی است که نشان می‌دهد با اعمال میدان مغناطیسی خارجی، مقاومت ویژه الکتریکی همه نمونه‌ها

<sup>۴</sup>- Spin glass

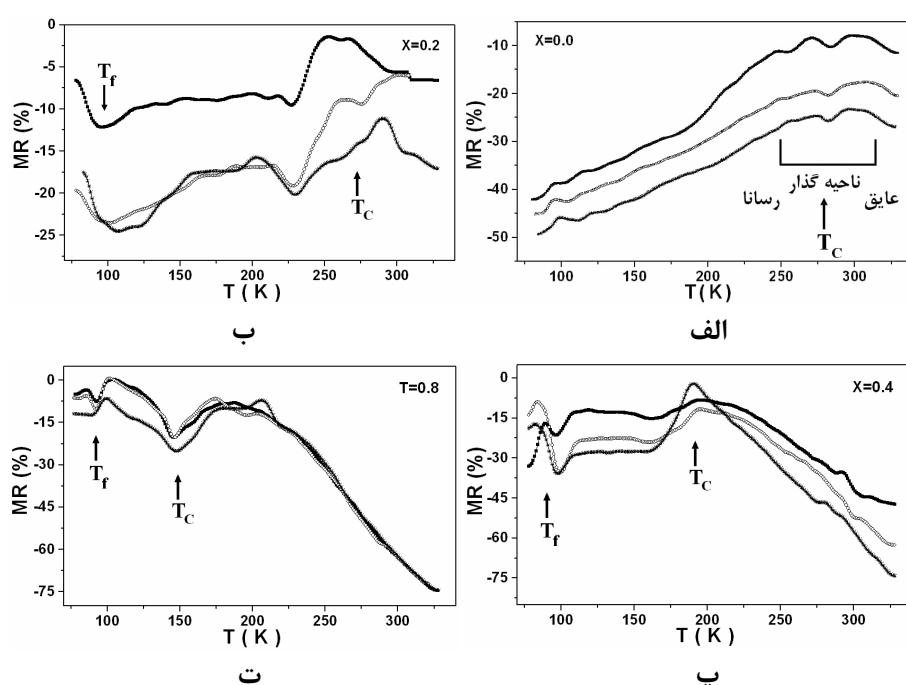
<sup>۵</sup>- Cluster glass

کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند ناشی از عوامل زیر باشد: (۱) تقویت بروهم‌کنش مبادله دوتایی در حضور میدان مغناطیسی از طریق اثر معکوس نظم فرومغناطیسی گشتاورهای مغناطیسی همسایه که در بالا توصیف شد. (۲) گسترش خوشهای همراستا با میدان مغناطیسی خارجی و کوچکشدن خوشهای ناهمراستا، که این امر افزایش احتمال تونل‌زنی حاملها بین خوشهای نیزکاهش احتمال پراکندگی حاملها از بین نظمی‌های مغناطیسی را در پی دارد [۱۵]. از این دو، سازوکار تونل‌زنی حاملها بین خوشهای مسؤول اثر CMR مشاهده شده در دماهای پایین است که با افزایش دما کاهش می‌یابد. علاوه بر این، برانگیختگی‌های گرمایی موجب کاهش نظم اسپینی بلندربرد در نمونه‌های  $x = 0$  با افزایش دما می‌شود که این آشفتگی بر اثر هم‌خط‌کنندگی میدان خارجی غالب است به نحوی که اندازه مغناطومقاومت این نمونه‌ها با افزایش دما کاهش می‌یابد.

با وجود این چنانکه که شکلهای ۷-پ تا ۷-ث نشان می‌دهند، مغناطومقاومت نمونه‌های حاوی درصد بالاتر کبات با افزایش دما بزرگتر می‌شود. در واقع دو پیامد دیگر، جز موارد بالا، را می‌توان برای حضور کبات در ترکیب‌های از این نوع در نظر گرفت [۱۱]: یکی کاهش ناهمسانگردی مغناطیسی و دیگری افزایش برهمنکنش تبادلی مستقیم. با کاهش ناهمسانگردی مغناطیسی، گشتاورهای مغناطیسی در حضور میدان خارجی آسان‌تر منظم می‌شوند. به این ترتیب، پراکندگی الکترونها کاهش می‌یابد که به صورت افزایش اندازه مغناطومقاومت در ناحیه دمای بالا در شکلهای ۶-پ و ۶-ت دیده می‌شود. در نمونه کباتیت (شکل ۵-ث برای  $x = 1$ )، برهمنکنش تبادلی مستقیم یونهای کبات باعث نظم آنها خواهد شد به نحوی که آرایش نسبی آنها با اعمال میدان خارجی تغییر قابل ملاحظه‌ای نمی‌یابد. بنابراین، مغناطومقاومت نمونه  $x = 1$  در ناحیه دمای بالا ثابت می‌ماند.

در مجموعه نمونه‌های مورد مطالعه و در ناحیه میدانهای قابل دسترس در این کار پژوهشی، تنها مغناطومقاومت نمونه  $x = 0.8$  (شکل ۶-ت) در ناحیه دمای اتاق رفتار اشباعی نشان می‌دهد و با افزایش میدان خارجی تغییر نمی‌کند.

چنانکه در جدول ۵ نشان می‌دهد، دمای گذار  $T_C$  نیز وابسته به میدان خارجی است. از آنجا که با اعمال میدان خارجی، نظم اسپینی و در نتیجه رفتار فرومغناطیسی بهبود می‌یابد، لذا دمای گذار  $T_C$  افزایش می‌یابد که با نتایج به دست آمده در این پژوهش سازگار است.



شکل ۷ بستگی دمایی مغناطیومقاومت نمونه‌های  $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.2}\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_2$  در حضور میدانهای مغناطیسی خارجی مختلف (■:  $H = 10 \text{ kOe}$ , \*:  $H = 5 \text{ kOe}$ , ○:  $H = 0 \text{ Oe}$ ).

جدول ۴ مقادیر گاف انرژی ترکیبات با  $x = 0.2, 0.4, 0.6$ .

X	Eg(ev)
0.2	0.09
0.4	0.19
0.6	0.13

جدول ۵ دمای گذار رسانا-نیمرسانا در نمونه  $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.25}\text{MnO}_3$  از شکل ۵-الف و ۷-الف.

میدان مغناطیسی	دمای گذار
$B = 0.0$ (mT)	278K
$B = 491$ (mT)	283K
$B = 980$ (mT)	285K
$B = 1440$ (mT)	288K

برداشت

نمونه‌های  $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{Mn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_3$  با  $x = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$  به روش سل-ژل ساخته شدند. نتایج نشان می‌دهند که دمای تشکیل فاز پرووسکایت در حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

مقایسه منحنی‌های مقاومت ویژه الکتریکی نمونه‌های مختلف نشان می‌دهد که با نشاندن کمالت به جای منگنز، مقاومت الکتریکی نخست افزایش و سپس کاهش می‌باید. این رفتار بر اساس واپیچش پیوندهای Mn-O-Co از حالت خطی و نیز پدیده جران حاملها قابل توصیف است. منحنی‌های وابستگی دمای مقاومت ویژه نمونه‌ها نشان‌دهنده دو دمای گذار  $T_C$  و  $T_f$  هستند که به ترتیب با دمای گذار فرو به پارامغناطیس، و دمای گذار بین حالت‌های اسپینی

مختلف کبالت برآش دارند. تغییر رفتار مقاومت ویژه نمونه‌ها از رسانانگونه به نیمرسانانگونه بر اساس تغییر سازوکار برهمنش مغناطیسی و نیز بافت ریزساختاری آنها قابل توصیف است. ضمن این که افزایش قابل توجه مقاومت نمونه‌های حاوی کبالت در دماهای پایین ناشی از گسترش نظم SG و CG در آنهاست.

نتایج نشان می‌دهند که مغناطیسومقاومت همه نمونه‌ها منفی است. رفتار مغناطیسومقاومت نمونه‌ها بر اساس تقویت برهمنش مبادله دوتایی در حضور میدان مغناطیسی و افزایش احتمال تونل زنی حاملها بین خوشها و کاهش احتمال پراکندگی حاملها از بی‌نظمی‌های مغناطیسی قابل بررسی است. افزایش مغناطیسومقاومت نمونه‌های حاوی درصد بالای کبالت با دما می‌تواند ناشی از کاهش ناهمسانگردی مغناطیسی و دیگری افزایش برهمنش تبادلی مستقیم در حضور کبالت باشد.

#### مراجع

- [1] E. Dagotto, et al., "Colossal magnetoresistant materials: the key role of phase separation", Physics Reports 344 (2001) 1153.
- [2] S. P. S. Badwal, et al., "Chemical diffusion in perovskite cathodes of solid oxide fuel cells: the Sr-doped  $\text{LaMn}_{1-x}\text{M}_x\text{O}_3$  ( $M = \text{Co, Fe}$ ) systems", Ceramics International 27 (2001) 419-429.
- [3] Emmanuel Syskakis, et al., "Crossover between Kondo and electron-electron interaction effects in  $\text{La}_{0.75}\text{Sr}_{0.2}\text{MnO}_3$  manganite doped with Co impurities", J. Phys.: Condens. Matter 15 (2003) 7735-7749.
- [4] A. N. Petrov, et al., "Crystal structure of the mixed oxides  $\text{La}_{0.7}\text{Sr}_{0.3}\text{Co}_{1-z}\text{Mn}_z\text{O}_{3-\frac{z}{2}}$  ( $0 < z < 1$ )", J. Solid State Chem. 143 (1999) 52-57.
- [5] V. V. Sikolenko, et al., "Neutron diffraction studies of  $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{CoO}_3$  magnetic structure at  $x=0.15$  and 0.3", J. Magn. Magn. Mater., 258-259 (2003) 300-301.
- [6] D. D. Khalyavin, et al., "Electrochemical growth and properties of  $\text{LaMn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_3$  ( $0 < x < 1$ ) single crystals", Crys. Res. Technol. 38 (2003) 748-754.
- [7] S. Kuharuangrong, et al., "Effects of Co and Fe addition on the Properties of Lathanum Strontium manganite", Materils Letters 58 (2004) 1964-1970.

- [8] Nguyen Xuan Phuc, et al., "Field dependence of zero-field-cooled magnetization of  $La_{1-x}Sr_xCoO_3$  ( $0.05 < x < 0.5$ )", J. Magn. Magn. Mater. 242-245 (2002) 754-756.
- [9] J. S. Srikanth, et al., "Magnetic ordering in  $La_{0.7}Sr_{0.3}Co_{1-x}Mn_xO_3$ ", Appl. Phys. A 74 (2002) S814-S816.
- [10] N. X. Phuc, et al., "Magnetic and Transport properties of  $La_{0.7}Sr_{0.3}Co_{1-y}Mn_yO_3$ ", Physica B 327 (2003) 177-182.
- [11] X. J. Fan, et al., "Transport and magnetic properties in perovskite compound  $La_{0.7}Sr_{0.3}Mn_{1-x}Co_xO_y$ ", J. Phys.: Condens. Matter 11 (1999) 3141-3148.
- [12] Kazuyoshi Suzuki, et al., "Magnetic, electrical and thermal properties of  $La_{0.8}Sr_{0.2}Mn_yCo_{1-y}O_3$ ", Physica B 329-333 (2003) 922-923.
- [13] Alazne Pena, et al., "Magnetotransport properties of Co- and Ni-doped manganites: from conductive to insulating behavior", J. Magn. Magn. Mater. 272-276 (2004) e1425-e1427.
- [14] G. Ch. Kostogloudis, et al., "Electronic conductivity in the  $Pr_{1-x}Sr_xCo_{1-y}Mn_y$  system", Solid State Ionics 118 (1999) 241-249.
- [15] A. Maignan, et al., "Enhancement of magnetoresistance in cobaltites by manganese substitution: the oxide  $La_{0.8}Sr_{0.2}Co_{1-x}Mn_xO_3$ ", Eur. Phys. J. B 13 (2000) 41-45.
- [16] S. Das, et al., "Influence of grain size and grain boundaries on the properties of  $La_{0.7}Sr_{0.3}Co_xMn_{1-x}O_3$ ", Solid State Communications 121 (2002) 691-695.
- [17] V. L. Kozhevnikov, et al., "Conductivity and carrier traps in  $La_{1-x}Sr_xCo_{1-z}Mn_zO_3$  ( $x = 0.3, z = 0, 0.25$ )", J. Solid State Chemistry 172 (2003) 296-304.
- [18] G. J. Chen, et al., "The effect of microstructure and secondary phase on magnetic and electrical properties of La-deficient  $La_{1-x}Mn_xO_3$  ( $0 < x < 0.3$ ) films", J. Magn. Magn. Mater. 219 (2000) 317-324.
- [19] M. Gaudon, et al., "Preparation and characterization of  $La_{1-x}Sr_xMnO_{3+\delta}$  powder by sol-gel processing", Solid State Sciences 4 (2002) 125-133.
- [20] Carlos Moure, et al., "Synthesis, sintering and electrical properties of  $YNi_{0.33}Mn_{0.67}O_3$  perovskite prepared by a polymerized method", J. Europ. Ceram. Soc. 23 (2003) 729-736.

- [21] W. Zhong, et al., "Synthesis, structure and magnetic entropy change of polycrystalline  $La_{1-x}K_xMnO_3$ ", J. Magn. Magn. Mater. 195 (1999) 112-118.
- [22] Nguyen Hoang Luong, et al., "On the magnetic and magnetocaloric properties of perovskite  $La_{1-x}Sr_xCoO_3$ ", J. Magn. Magn. Mater. 242-245 (2002) 760-762.